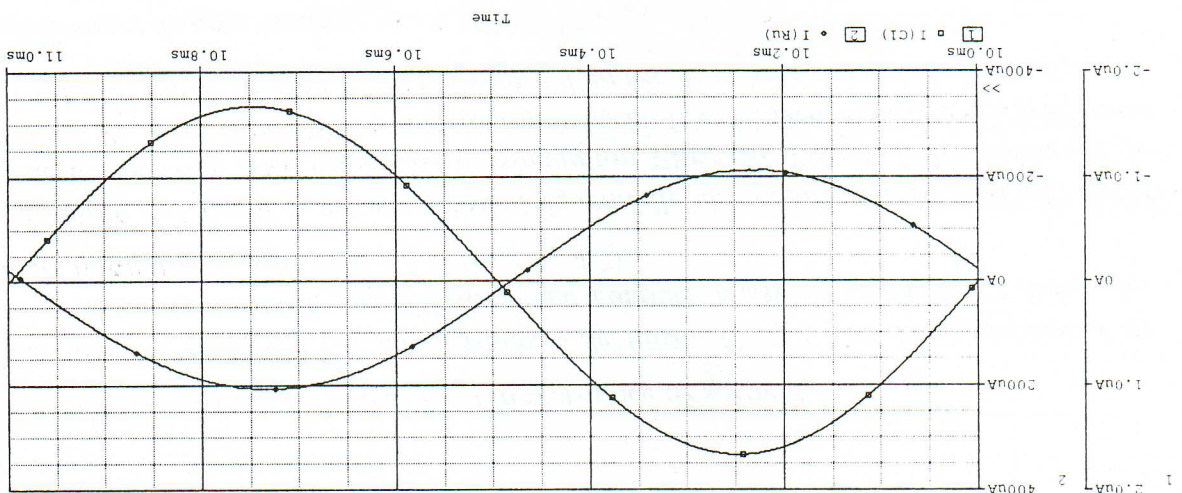


$$A_v = \frac{V_s}{V_e} = -207 \quad (\text{les deux valeurs crêtes ont été relevées avec le curseur})$$



$$A_i = \frac{I_s}{I_e} = -125 \quad (\text{les deux valeurs crêtes ont été relevées avec le curseur})$$

1.2 - Amplificateur à deux étages à très grande résistance d'entrée

La tension d'alimentation est $V_{cc} = +15\text{ V}$.

Le JFET T_1 est un transistor 2N4393. Son point de repos désiré est défini par $V_{GS} = -1\text{ V}$,

$V_{DS} = 7\text{ V}$ et $I_D = 1\text{ mA}$ et il a une transconductance $g_m = 6\text{ mS}$ pour ce point de repos.

Le transistor bipolaire T_2 est un transistor 2N2222. Son point de repos désiré est défini

par $I_C = 5\text{ mA}$ et il a un gain en courant $\beta = 175$.

Le générateur d'attaque a une résistance de sortie $R_g = 47\text{ k}\Omega$

La résistance de charge est $R_u = 4,7\text{ k}\Omega$

$R_C = 1\text{ M}\Omega$